




	<h2 style="color: red;">FQD4N20TF</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD4N20TF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 3A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD4N20TF.pdf</a> <a href="#">2.FQD4N20TF.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 10000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD4N20TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 3A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	10000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 3A (Tc) 2.5W (Ta), 30W (Tc) Surface
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 30W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 1.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	220pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD4N20TF ist neu im Original, Suche FQD4N20TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD4N20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD4N20TF: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD4N20TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3A DPAK</p>	 <p><b>FQD4N20TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3A DPAK</p>	 <p><b>FQD4N25TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 3A DPAK</p>	 <p><b>FQD4N20TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3A DPAK</p>
 <p><b>FQD4N25</b> FAIRCHI FQD4N25 FAIRCHI</p>	 <p><b>FQD4N20LTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.2A DPAK</p>	 <p><b>FQD4N25S</b> FAIRCHI FAIRCHI TO-252</p>	 <p><b>FQD4N20LTF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.2A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD3N40TM	↔ FQD3N50C	⇒ FQD3N50C/CS	D FQD3N50CTF	⇒ FQD3N50CTF
⊕ FQD3N50CTM	⊗ FQD3N50CTM	D FQD3N60C	⇒ FQD3N60CS	⇒ FQD3N60CTF
⊗ FQD3N60CTM	⊕ FQD3N60CTM_WS	⊗ FQD3N60TF	↔ FQD3N60TF	⇒ FQD3N60TM
D FQD3N60TM	⊗ FQD3P20TF	⊕ FQD3P20TF	⊗ FQD3P50TF	⇒ FQD3P50TF
⇒ FQD3P50TM	↔ FQD3P50TM	⊗ FQD4N20L	⊕ FQD4N20LTF	⇒ FQD4N20LTF
↔ FQD4N20TF	⇒ FQD4N20TM	D FQD4N20TM	⊗ FQD4N25TM	⊕ FQD4N25TM
⊗ FQD4N50S	D FQD4N50T	⇒ FQD4N50TF	↔ FQD4N50TF	⇒ FQD4N50TM
⊕ FQD4N50TM	⊗ FQD4N60C	↔ FQD4N60CTM	⇒ FQD4N65C	⇒ FQD4P25TM
⊗ FQD4P25TM	⊕ FQD5N15TF	⊗ FQD5N15TF	D FQD5N15TM	⇒ FQD5N15TM
↔ FQD5N20L	⊗ FQD5N20LTM	⊕ FQD5N20LTM	⊗ FQD5N20TF	⇒ FQD5N20TF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited